Diotec Semiconductor

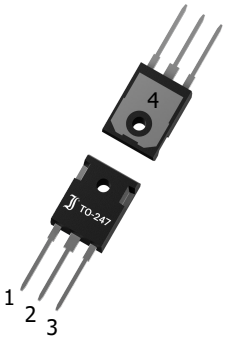
DIW120SIC023

Silicon Carbide (SiC) MOSFET
Siliziumkarbid (SiC) MOSFET

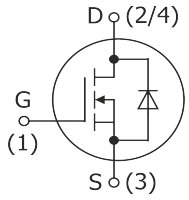
I_D	= 130 A	V_{DSS}	= 1200 V
$R_{DS(on)}$	< 23 mΩ	P_D	= 600 W
T_{jmax}	= 175°C	E_{AS}	= TBD mJ

Version 2023-11-02

TO-247



SPICE Model & **STEP** File [1])



Marking
Type/Typ

HS Code 85412900

Typical Applications
DC/DC Converters
Power Supplies
DC Drives
Power Tools
Commercial / industrial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant [1])
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification [1])

Typische Anwendungen
Gleichstrom-Wandler
Stromversorgungen
Gleichstrom-Antriebe
Elektrowerkzeuge
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform [1])
Suffix -AQ: AEC-Q101 Qualifikation [1])

Features
Advanced Trench Technology
Low on state resistance
Fast switching times
Low gate charge
Avalanche rated
100% Avalanche tested
Compliant to RoHS (examp. 7a), REACH, Conflict Minerals [1])

Halogen FREE

Besonderheiten
Advanced Trench Technologie
Niedriger Einschaltwiderstand
Schnelle Schaltzeiten
Niedrige Gate-Ladung
Avalanche-Charakteristik
100% Avalanche geprüft
Konform zu RoHS (Ausn. 7a), REACH, Konfliktmineralien [1])

Mechanical Data [1])		**Mechanische Daten [1])**
Packed in tubes/cardboards	30/450	Verpackt in Stangen/Kartons
Weight approx.	6 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL 1	Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings [2]) **Grenzwerte [2])**

			DIW120SIC023-AQ
Drain-Source voltage Drain-Source-Spannung	V_{GS} = 0 V (short)	V_{DSS}	1200 V
Gate-Source-voltage Gate-Source-Spannung	AC recommend	V_{GSS}	-10 V to 25 V -4 V to 18 V
Power dissipation – Verlustleistung	T_C = 25°C [3])	P_{tot}	600 W
Drain current continous Drainstrom dauernd	T_C = 25°C [3]) T_C = 100°C [3])	I_D	125 A 100 A
Peak Drain current – Drain-Spitzenstrom	[4])	I_{DM}	260 A
Source current continous Sourcestrom dauernd	T_C = 25°C [3])	I_S	100 A
Single pulse avalanche energy (Fig. 1) Einzelpuls Avalanche-Energie	I_{AS} = TBD A, V_{GS} = 10 V L = 79 mH, R_G = 25 Ω	E_{AS}	TBD mJ
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	-55…+175°C -55...+175°C

1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C, unless otherwise specified – T_A = 25°C, wenn nicht anders angegeben
3 Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne
4 Pulse width refer to SOA diagram – Pulsbreite siehe SOA-Diagramm

Preliminary Vorläufig

Characteristics (static) **Kennwerte (statisch)**

		T_j = 25°C	Min.	Typ.	Max.
Drain-Source breakdown voltage – Drain-Source-Durchbruchspannung					
I_D = 100 µA V_{GS} = 0 V (short)	$V_{(BR)DSS}$		1200 V	–	–
Drain-Source leakage current – Drain-Source Leckstrom					
V_{DS} = V_{DSS} V_{GS} = 0 V (short)	I_{DSS}		–	1 µA	50 µA
Gate-Body leakage current – Gate-Substrat Leckstrom					
V_{GS} = 18 V V_{DS} = 0 V (short)	I_{GSS}		–	–	250 nA
Gate-Source threshold voltage – Gate-Source Schwellspannung					
V_{GS} = V_{DS} I_D = 25 mA V_{GS} = V_{DS} I_D = 25 mA	$V_{GS(th)}$	T_j = 25°C T_j = 175°C	–	2.9 V 2 V	–
Drain-Source on-state resistance – Drain-Source Einschaltwiderstand					
V_{GS} = 18 V I_D = 75 A V_{GS} = 18 V I_D = 75 A	$R_{DS(on)}$	T_j = 25°C T_j = 175°C	–	16 mΩ 29 mΩ	23 mΩ –

Characteristics (dynamic) **Kennwerte (dynamisch)**

		T_j = 25°C	Min.	Typ.	Max.
Forward Transconductance – Übertragungssteilheit					
V_{DS} = 20 V I_D = 75 A	g_{FS}		–	60 S	–
Input Capacitance – Eingangskapazität					
V_{DS} = 1 kV V_{GS} = 0 V f = 1 Mhz V_{AC} = 25 mV	C_{iss}		–	6150 pF	–
Output Capacitance – Ausgangskapazität					
V_{DS} = 1 kV V_{GS} = 0 V f = 1 Mhz V_{AC} = 25 mV	C_{oss}		–	260 pF	–
Reverse Transfer Capacitance – Rückwirkungskapazität					
V_{DS} = 1 kV V_{GS} = 0 V f = 1 Mhz V_{AC} = 25 mV	C_{rss}		–	19 pF	–
Turn-On Delay & Rise Time – Einschaltverzögerung und Anstiegszeit					
V_{DD} = 800 V I_D = 75 A V_{GS} = -4V/18 V L = 276 nH	$t_{d(on)}$ t_r		–	TBD TBD	–
Turn-Off Delay Time & Fall Time – Ausschaltverzögerung und Abfallzeit					
V_{DD} = 800 V I_D = 75 A V_{GS} = -4V/18 V L = 276 nH	$t_{d(off)}$ t_f		–	TBD TBD	–
Switching Energy – Schaltenergie					
V_{DD} = 800 V I_D = 75 A V_{GS} = -4V/18 V L = 276 nH	E_{on} E_{off} E_{total}		–	TBD TBD TBD	–
Total Gate Charge – Gesamte Gate-Ladung					
V_{DD} = 800 V I_D = 75 A V_{GS} = -4V/18 V	Q_g		–	45 nC	–
Gate-Source Charge – Gate-Source-Ladung					
V_{DD} = 800 V I_D = 75 A V_{GS} = -4V/18 V	Q_{gs}		–	9 nC	–
Gate-Drain Charge – Gate-Drain-Ladung					
V_{DD} = 800 V I_D = 75 A V_{GS} = -4V/18 V	Q_{gd}		–	21 nC	–
Intrinsic Gate resistance – Innerer Gatewiderstand					
f = 1 Mhz V_{AC} = 25 mV	R_{Gi}		–	0.5 Ω	–

Preliminary Vorläufig

 © Diotec Semiconductor AG

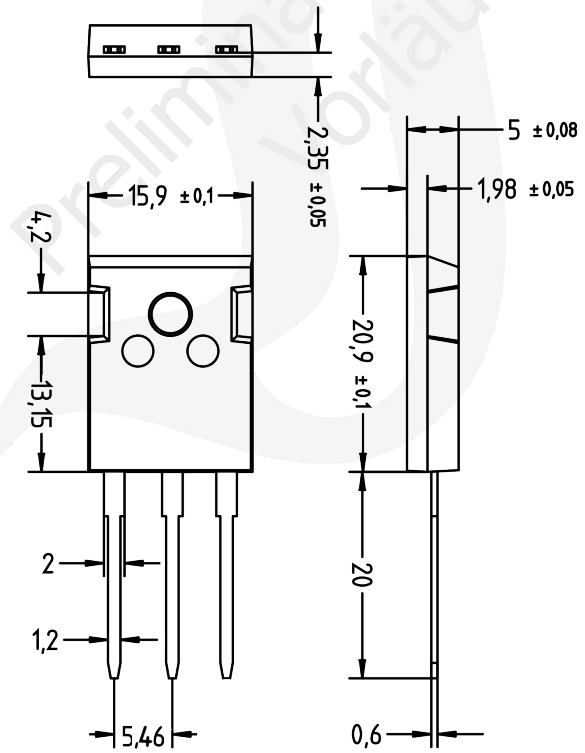
Characteristics (diode) **Kennwerte (Diode)**

		T_j = 25°C	Min.	Typ.	Max.
Forward voltage – Durchlass-Spannung					
$-V_{GS}$ = 4 V	I_S = 75 A	V_{SD}	–	–	3.9 V
Reverse recovery time – Sperrverzugszeit					
$-V_{GS}$ = 4 V	I_S = 75 A, di/dt = -100 A/µs	t_{rr}	–	TBD	–
Reverse recovery charge – Sperrverzugsladung					
$-V_{GS}$ = 4 V	I_S = 75 A, di/dt = -100 A/µs	Q_{rr}	–	TBD	–
Peak reverse recovery current – Sperrverzug-Peak-Strom					
$-V_{GS}$ = 4 V	I_S = 75 A, di/dt = -100 A/µs	I_{rrm}	–	TBD	–

Characteristics (thermal) **Kennwerte (thermisch)**

Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse	R_{thC}	Typ. 0.25 K/W [1])
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung	R_{thA}	< 40 K/W

Dimensions - Maße [mm]



Preliminary Vorläufig

Disclaimer: See data book page 2 or website
Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet

1 Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others. Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website [1]). All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" [2]). The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are intended for applications up to ASIL B, but not for ASIL C or D [3]).

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting medical, defence, aerospace, submarines, nuclear power etc, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate. Usage in medical devices is limited to applications with maximum class I according to Regulation (EU) 2017/745.
Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. If these products are to be used in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability (refer to item 3.), in which failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, user shall contact in advance Diotec Semiconductor AG's Managing Board (Heitersheim, Germany) to confirm that the intended use of the product is appropriate.

5. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

6. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

7. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

8. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Germany, this product must not be exported without obtaining an export license from the Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Germany in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.
Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht [1]). Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" [2]). Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform" oder „AEC-Q101 qualifiziert" erhältlich. Diese sind für Anwendungen bis maximal ASIL B bestimmt, nicht aber für ASIL C oder D [3]).

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Medizintechnik, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Unterwasserfahrzeuge, Nukleartechnik etc. ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist. Die Anwendung in Medizinprodukten ist für Anwendungen mit höchstens Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 zulässig.
Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern (siehe Punkt 3.), insbesondere wenn durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, muss im Voraus der Vorstand der Diotec Semiconductor AG (Heitersheim, Deutschland) bestätigen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

5. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

7. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

8. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie exportiert werden.

1 Refer to http://diotec.com/ "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe http://diotec.com/ „Produkte/Produktänderungen" bzw. „News/Datenblätter"

2 Refer data book or http://diotec.com/ "Company" – Siehe Datenbuch oder http://diotec.com/ „Unternehmen"

3 Refer to http://diotec.com/ "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe http://diotec.com/ „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101"